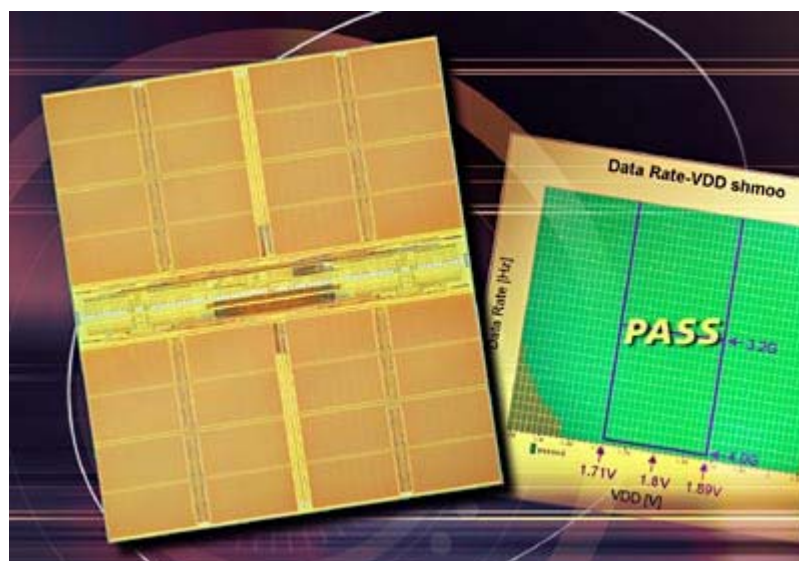


2006年3月22日

## XDR™ DRAM、最先端 90nm プロセスでの量産準備完了

マーケットの広がりに応える生産性と高速性能を達成



エルピーダメモリ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：坂本幸雄以下、エルピーダ）は、このたび、90nm プロセスを採用した超高速 DRAM、512M ビット XDR DRAM を開発し、その量産の準備を完了いたしました。

エルピーダは、昨年 3 月より前世代の 100nm プロセス品のサンプル出荷を行っておりますが、それに並行して、本格的なマーケットの立ち上がりを見据えた量産準備を進めてまいりました。

その結果、100nm プロセス品に比べ、20%余り生産性が向上する 90nm プロセスでの製品開発を完了し、量産の準備を整えるに至りました。

加えて、XDR DRAM で最高速の 4.0GHz での安定した動作を改めて確認いたしました。

XDR DRAM は、次世代のコンピュータ・エンタテインメント・システムや、高画質 HDTV を代表とするデジタル家電市場をターゲットにした超高速 DRAM です。

当社デジタルコンシューマ機器向け DRAM の開発を担当する部門の執行役員である木下嘉隆は次のように述べています。「今後、本格的な需要を迎える本製品は、3.2GHz の

スピードが主流と見られていますが、高精細な画像などを取り扱うデジタル家電においては、その膨大なデータを処理するために、より高速なスピードも必要となっています。安定した生産性で、最高速 4.0GHz をサポートするエルピーダの 512M ビット XDR DRAM は、このような市場の要求に最適です。」

また、XDR DRAM アーキテクチャーを開発したラムバス社のプラットフォーム ソリューションズ の上級副社長であるローラ スターク (Laura Stark) 氏からは、「我が社のパートナーであるエルピーダが、最高速 4.0GHz の安定動作を実現した超高速 DRAM、XDR DRAM の 90nm プロセスでの量産体制を整備されたことを大変喜ばしく思っています。現在、急速に普及している HDTV など高性能デジタルコンシューマ機器向けデバイスとして、エルピーダの XDR DRAM は最適なソリューションと言えます。」というコメントをいただいております。

エルピーダは、今後も、XDR DRAM のプライマリーサプライヤーを目指し、生産性、および性能向上を図ってまいります。

512M ビット XDR DRAM の主な仕様は別紙をご覧ください。

以 上

XDR は米国およびその他の国におけるラムバス社の商標です。その他記載されている製品名、会社名は、ラムバス社もしくは保有各社の登録商標または商標です。

ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

報道関係からのお問い合わせ先  
エルピーダメモリ株式会社  
広報グループ 高橋 / 小林  
電話 : 03-3281-1648  
E-mail : [press@elpida.com](mailto:press@elpida.com)

## 別紙

## 512M ビット XDR DRAM の主な仕様

製品名	EDX5116ACSE シリーズ
製造プロセス	90nm CMOS
構成	4M ワード × 16 ビット × 8 バンク
データ幅	× 4 / × 8 / × 16 ビット プログラマブル
ピンあたりデータ転送レート	4C : 4.0GHz 3A/3B/3C : 3.2GHz
インターフェース	DRSL (DQ ピン)、RSL (RQ ピン)
XDR テクノロジ	Octal Data Rate、DRSL、Flex Phase
電源電圧 (VDD)	1.8V ± 0.09V
動作温度範囲 (Tj)	0 ~ 100 (Tj : ジャンクション温度)
パッケージ	104 ボール FBGA